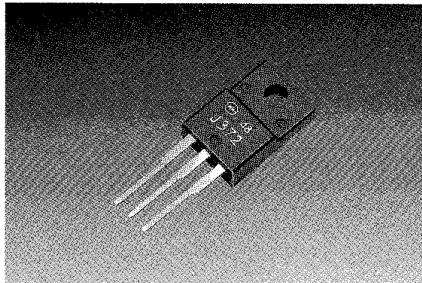


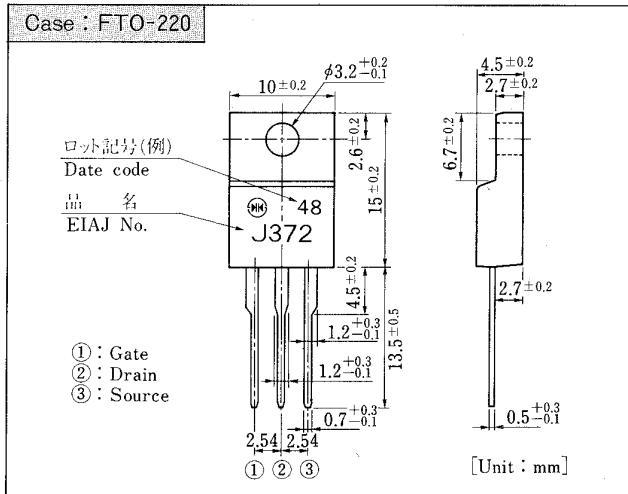
60Vシリーズ パワーMOSFET 60V SERIES POWER MOSFET

高速スイッチング
P-チャネル、エンハンスマント型

2SJ372
(F15F6P)
-60v -15A



■ 外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



■ 定格表 RATINGS

■ 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55 ~ 150	°C
チャネル温度 Channel Temperature	Tch		150	°C
ドレイン・ソース電圧 Drain-Source Voltage	V _{DSS}		-60	V
ゲート・ソース電圧 Gate-Source Voltage	V _{GSS}		\pm 20	V
ドレイン電流 Continuous Drain Current	ID		-15	A
Peak	IDP	パルス幅 \leq 10μs, duty \leq 1/100 Pulse width \leq 10μs, Duty cycle \leq 1/100	-60	A
ソース電流(直流) Continuous Source Current (DC)	I _S		-15	A
全損失 Total Power Dissipation	P _T	T _C =25°C	40	W
单発アバランシェ電流 Single pulse Avalanche Current	I _{AS}	T _C =25°C	-15	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 3 kg·cm) (Recommended torque : 3 kg·cm)	5	kg·cm

■ 電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (T_C=25°C)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース降伏電圧 Drain-Source Breakdown Voltage	V _{(BR)DSS}	Id=-1mA, V _{GS} =0V	-60			V
ドレイン遮断電流 Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}	V _{Ds} =-60V, V _{GS} =0V			-100	μA
ゲート漏れ電流 Gate-Source Leakage Current	I _{GSS}	V _{GS} = \pm 20V, V _{Ds} =0V			\pm 10	μA
順伝達コンダクタンス Forward Transconductance	g _{fs}	Id=-7.5A, V _{Ds} =-10V	6.3	9.0		S
ドレイン・ソース間オン抵抗 Static Drain-Source On-state Resistance	R _{Ds(ON)}	Id=-7.5A, V _{GS} =-10V		0.07	0.10	Ω
ゲートしきい値電圧 Gate Threshold Voltage	V _{TH}	Id=-1mA, V _{Ds} =-10V	-1.0	-1.5	-2.0	V
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧 Source-Drain Diode Forward Voltage	V _{SD}	Is=-7.5A, V _{GS} =0V			-1.5	V
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case			3.12	°C/W
ゲートチャージ特性 Gate Charge Characteristics	Q _g	V _{GS} =-10V, Id=-15A, V _{DD} =-48V		-58		nC
入力容量 Input Capacitance	C _{iss}			1350		
帰還容量 Reverse Transfer Capacitance	C _{rss}	V _{Ds} =-10V, V _{GS} =0V, f=1MHz		340		pF
出力容量 Output Capacitance	C _{oss}			700		
ターンオン時間 Turn-on Time	t _{on}	Id=-7.5A, V _{GS} =-10V, R _L =4Ω		110	220	ns
ターンオフ時間 Turn-off Time	t _{off}			480	960	